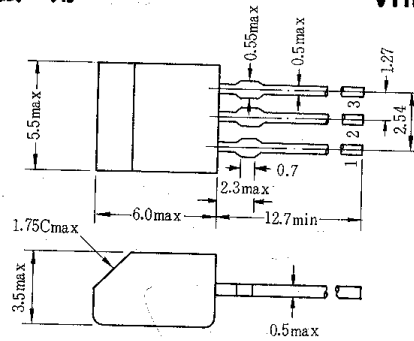


シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形
VHF 増幅, 混合, 発振用

SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR
VHF RF AMPLIFIER, MIXER, OSCILLATOR



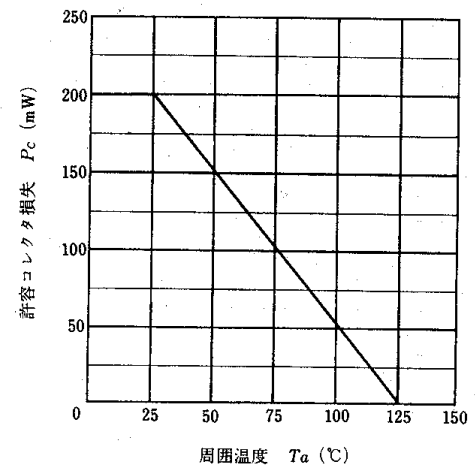
- 1. エミッタ: Emitter
 - 2. コレクタ: Collector
 - 3. ベース: Base
- (Dimensions in mm)

(EPOXY RESIN MOLD)

■ 最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SC717	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	19	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	2	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
エミッタ電流	I_E	-50	mA
許容コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION
CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	30	-	-	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=3\text{mA}, R_{BE}=\infty$	19	-	-	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	2	-	-	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0$	-	-	500	nA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	40	-	-	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=20\text{mA}, I_B=4\text{mA}$	-	0.2	1.0	V
高周波電流増幅率	h_{fe}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	6	-	-	
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	1.2	2.0	pF
ベース時定数	$r_{bb} \cdot C_c$	$V_{CB}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=31.8\text{MHz}$	-	10	25	ps
電力利得	PG	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=5\text{mA}, f=45\text{MHz}$	-	33	-	dB
電力利得	PG	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=5\text{mA}, f=200\text{MHz}$	-	18	-	dB

注) 新規設計の際は 2SC1906 をご採用ください。
Note) Use Hitachi Type 2SC1906 Transistor for newly designed products.